PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-181045

(43) Date of publication of application: 18.07.1995

(51)Int.CI.

G01C 19/72 G02B 6/122 H01S 3/07 H01S 3/083

(21)Application number: 05-327972

(71)Applicant: TOKIMEC INC

(22)Date of filing:

24.12.1993

(72)Inventor: NAKAMURA SHIGERU

HOJO TAKESHI

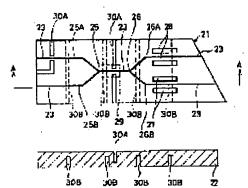
WATANABE KUNIYOSHI

(54) OPTICAL INTEGRATED CIRCUIT AND OPTICAL FIBER GYRO

(57)Abstract:

PURPOSE: To protect a waveguide intrusion of light propagating through the substrate of an optical integrated circuit.

CONSTITUTION: The substrate 22 for an optical integrated circuit 21 is provided with bands 30A, 30B for blocking the light propagating through the substrate 22 thus protecting a waveguide 23 against intrusion of the light propagating through the substrate 22. When such optical integrated circuit is employed in an optical fiber gyro, a noise-free gyro signal can be obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

01.10.2002

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-181045

(43)公開日 平成7年(1995)7月18日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 **广内整理番号** FΙ

技術表示箇所

G01C 19/72

L 9402-2F

9402-2F

G 0 2 B 6/122

H01S. 3/07

G02B 6/12

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 10 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平5-327972

(71)出願人 000003388

株式会社トキメック

(22)出願日 平成5年(1993)12月24日 東京都大田区南蒲田2丁目16番46号

(72)発明者 中村 茂

東京都大田区南蒲田 2 丁目16番46号 株式

会社トキメック内

(72) 発明者 北條 武

東京都大田区南蒲田2丁目16番46号 株式

会社トキメック内

(72)発明者 渡邉 邦芳

東京都大田区南蒲田 2 丁目16番46号 株式

会社トキメック内

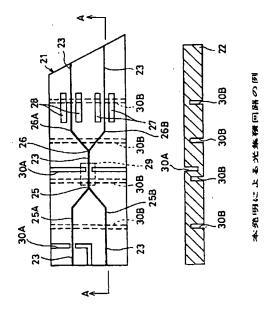
(74)代理人 弁理士 松限 秀盛

(54) 【発明の名称】 光集積回路及び光ファイバジャイロ

(57)【要約】

【目的】 光集積回路の基板の内部を伝播する光が導波 路に混入しないようにすることを目的とする。

【構成】 光集積回路21の基板22に遮断帯30A、 30Bを設け、基板22の内部を伝播する光を遮断し、 導波路23に混入しないように構成する。光ファイバジ ャイロに斯かる光集積回路21を使用することによっ て、ノイズを含まないジャイロ信号を得ることができ る。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板とその上面に形成された導波路とを 有する光集精同路において、

上記導波路を横断して上記基板の両側まで延在する遮断 帯を設け、該遮断帯によって上記導波路より洩れた光が 上記基板内を伝播することを防止するように構成されて いることを特徴とする光集積回路。

【請求項2】 請求項1記載の光集積回路において、

上記基板の上面以外の各面に反射防止膜が設けられ、該 反射防止膜によって上記基板内を伝播する光が上記基板 10 の上面以外の各面に反射することが防止されるように構 成されていることを特徴とする光集積回路。

【請求項3】 請求項1又は2記載の光集積回路におい て、

上記遮断帯は上記基板の下面に形成された溝を含み、上 記導波路を切断することなく、上記基板の両側まで延在 していることを特徴とする光集積回路。

【請求項4】 請求項1、2又は3記載の光集積回路に おいて

上記遮断帯は上記基板の上面に形成された溝を含み、該 20 溝は上記導波路を切断することなく、上記導波路の両側 より上記基板の両側まで延在していることを特徴とする 光集積回路。

【請求項5】 請求項1、2、3又は4記載の光集積回 路において

上記基板はLiNbO,又はLiTaO,のいずれかに よって構成されていることを特徴とする光集積回路。

【請求項6】 請求項1、2、3、4又は5記載の光集 積回路において、

上記導波路はTi熱拡散法によって形成されていること 30 を特徴とする光集積回路。

【請求項7】 請求項1、2、3、4、5又は6記載の 光集積回路において、

上記導波路はプロトン交換法によって形成されているこ とを特徴とする光集積回路。

【請求項8】 請求項1、2、3、4、5、6又は7記 載の光集積回路において、

第1及び第2のY分岐と該第2のY分岐の分岐枝に沿っ て設けられた位相変調器とを有し、上記第1のY分岐の 一方の分岐枝の先端に光源を接続し他方の分岐枝の先端 40 に受光器を接続し上記第2のY分岐の各分岐枝の先端に 光ファイバループの各端部を接続することによって光フ ァイバジャイロが構成される光ファイバジャイロ用であ ることを特徴とする光集積回路。

【請求項9】 光源と光集積回路と光ファイバループと 受光器とを有する光ファイバジャイロにおいて、

上記光集積回路は基板と該基板の上面に形成された導波 路と該導波路を横断して上記基板の両側まで延在する遮 断帯とを有し、該遮断帯によって上記導波路より洩れた 光が上記基板内を伝播することを防止するように構成さ 50 3内を互いに反対方向に伝播する光に位相差△Φが生ず

れていることを特徴とする光ファイバジャイロ。 【請求項10】 請求項9記載の光ファイバジャイロに

上記遮断帯は上記基板の下面に形成された溝を含み、上 記導波路を切断することなく、上記基板の両側まで延在 していることを特徴とする光ファイバジャイロ。

【請求項11】 請求項9又は10記載の光ファイバジ ャイロにおいて.

上記遮断帯は上記基板の上面に形成された溝を含み、該 溝は上記導波路を切断することなく、上記導波路の両側 より上記基板の両側まで延在していることを特徴とする 光ファイバジャイロ。

【請求項12】 請求項9、10又は11記載の光ファ イバジャイロにおいて、

上記基板の側面と下面には反射防止膜が装着され、該反 射防止膜によって上記基板内を伝播する光が上記基板の 上面以外の各面に反射することが防止されるように構成 されていることを特徴とする光ファイバジャイロ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は角速度を測定するための 光ファイバジャイロ及び光ファイバジャイロに使用して 好適な光集積回路に関する。

[0002]

【従来の技術】光ファイバジャイロは光のサグナック効 果(サニャック効果)を利用して角速度を計測するよう に構成されており、高い信頼性を有し装置を小型化する ことができる利点がある。光ファイバジャイロのうち、 干渉型光ファイバジャイロと称する形式のものがあり、 これは複数回巻かれた光ファイバループよりなる1本の 長い光路を互いに反対方向に光を伝播させ斯かる2つの 伝播光の位相差より角速度を求めるように構成されてい

【0003】図6は位相差変調方式の光ファイバジャイ ロの例を示す。光ファイバジャイロは、半導体レーザ、 発光ダイオード等の光源101と入射光を電流に変換す る受光器102と1本の光ファイバを複数回巻いて形成 された光ファイバループ103と偏光子104と光ファ イバを伝播する光を合成し又は分岐するカプラ105、 106とを有する。

【0004】光源101より出力された光線は第1のカ プラ105及び偏光子104を経由して第2のカプラ1 06に導かれる。第2のカプラ106で光線は分岐さ れ、斯くして分岐された2つの光線は光ファイバループ 103を互いに反対方向に伝播する。即ち、一方は光フ ァイバループ103を右周りに伝播し、他方は左周りに 伝播する。

【0005】光ファイバループ103に角速度Qが加わ ると、サグナック効果によって、光ファイバループ10

る。斯かる位相差Δφは角速度Ωに比例し、次の式で表。 される。

[0006]

【数1】Δφ= (4πLR/λC)Ω

【0007】 ここに、Ωは光ファイバループ103の中 心軸線周りの角速度、Rは光ファイバループ103のル ープ径、Lは光ファイバループ103の長さ、λは光源 101から出力される光線の波長、Cは光速を表す。

【0008】この光ファイバジャイロは、更に、電流・ 電圧変換器107と位相変調器108と信号発生器10 10 【数2】 9と同期検波器110とを有する。受光器102より出*

 $I = K \left[1 + \cos \Delta \phi \cdot \{J_o(z) - 2J_z(z) \cos 2\omega, t + \cdot \cdot \} \right]$ $-\sin\Delta\phi\cdot\{2J_1(z)\cos\omega_e\ t-\cdots\}$]

【0010】となる。とこで、xは位相変調度、J。、 J,、J,、・・・はベッセル関数、Kは比例定数、t は時間である。

【0011】同期検波器110には信号発生器109か **ら角周波数ω, の信号が供給され、斯かる基準信号によ** って出力電圧Vの角周波数nω,成分のうち角周波数成 分ω, が同期検波され、sin Δ φ に比例する出力2 K 20 J_{1} (x) s i n Δ ϕ が出力される。こうして、 Δ ϕ を 求めて、数1の式より角速度Ωが求められる。

【0012】位相差変調方式の光ファイバジャイロを改 良したものとしてセロダイン方式の光ファイバジャイロ が知られている。斯かるセロダイン方式では位相変調器 108の他に更にセロダイン位相変調器108'が設け られている。尚、セロダイン方式の光ファイバジャイロ の詳細については本願出願人と同一の出願人による特願 平4-306975号を参照されたい。

【0013】図7及び図8に従来の光ファイバジャイロ 30 の他の例を示す。図7Aに示す例を除いて、即ち、図7 B、図8A及び図8Bに示すの例では光集積回路115 が使用されている。図7Aに示す例は図6の例と同様で ある。図7Bに示す光ファイバジャイロでは、カプラ1 05、1つのY分岐118、偏光子104、位相変調器 108及びセロダイン位相変調器108′が単一の光集 稽回路115に組み込まれている。

【0014】図8Aに示す光ファイバジャイロでは、2 つのY分岐118、118、偏光子104、位相変調器 108及びセロダイン位相変調器108'が単一の光集 40 ことを目的とする。 積回路115に組み込まれている。図8Bに示す光ファ イバジャイロでは、偏光子104、1つのY分岐、位相 変調器108及びセロダイン位相変調器108'が単一 の光集積回路115に組み込まれている。カプラ105 は光集積回路115に組み込まれていない。

【0015】光集積回路115の両端には接続装置11 6、116が装着されており、一方の接続装置116に よっては光集積回路115の導波路の端部は光ファイバ 131を経由して光ファイバループ103に接続され、 他方の接続装置131によっては光集積回路115の導 50 防止膜が設けられ、反射防止膜によって基板22内を伝

*力された電流は電流・電圧変換器107によって電圧に 変換され電圧として出力される。位相変調器108は光 ファイバループ103の一端に配置されており、信号発 生器109から供給された基準信号によって作動され る。位相変調器108によって光ファイバループ103 内を互いに反対方向に伝播する光が位相変調される。信 号発生器109から供給される信号の角周波数をω。と すれば、電流・電圧変換器107の出力電圧Vは、

[0009]

波路の端部は光ファイバ131を経由して光源101及 び受光器102に接続されている。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】光集積回路115は基 板の上面に回路を形成することによって構成される。カ プラ105及びY分岐118は導波路によって形成され ている。従来の光集積回路115は少なくとも1つのY 分岐118を含み、斯かるY分岐118から光の一部が 洩れ基板内に放射される。斯かる光は基板内で結合し干 渉し再び導波路に戻り、導波路を伝播する光に不要成分 として含まれることとなる。

[0017]一般に、基板内を伝播する光が存在すると それが導波路に侵入して導波路を伝播する光に混入され ることとなる。それによって、導波路を伝播する光が搬 送している信号にノイズが生ずる。

【0018】光ファイバジャイロに光集積回路115を 使用する場合、基板内を伝播する光の存在によって、搬 送信号にノイズが生じ、それは更にジャイロ信号にノイ ズとして重畳され、測定精度の低下を招く。

【0019】本発明は、斯かる点に鑑み、基板内を伝播 する光に起因して導波路を伝播する光が搬送している信 号にノイズが生ずることがない光集積回路115を提供 することを目的とする。

【0020】本発明は、斯かる点に鑑み、光集積回路1 15の基板内を伝播する光に起因してジャイロ信号にノ イズが生ずることがない光ファイバジャイロを提供する

[0021]

【課題を解決するための手段】本発明によると、基板2 2とその上面に形成された導波路23とを有する光集積 回路において、導波路23を横断して基板22の両側ま で延在する遮断帯30A、30Bを設け、遮断帯30 A、30Bによって導波路23より洩れた光が基板22 内を伝播することを防止するように構成されている。 【0022】本発明によると、光集積回路において、基

板22の上面以外の各面22A、22B、22Cに反射

掻する光が基板22の上面以外の各面に反射することが

防止される。

【0023】本発明によると、光集積回路において、遮 断帯30A、30Bは基板22の下面に形成された溝で あり、導波路23を切断することなく、基板22の両側 まで延在している。

【0024】本発明によると、光集積回路において、遮 断帯30A、30Bは基板22の上面に形成された溝を 含み、溝は導波路23を切断することなく、導波路23 の両側より基板22の両側まで延在している。

【0025】本発明によると、光集積回路において、基 板22はLiNbO,又はLiTaO,のいずれかによ って構成されている。

【0026】本発明によると、光集積回路において、導 波路23はTi熱拡散法によって形成されている。

【0027】本発明によると、光集積回路において、導 波路23はプロトン交換法によって形成されている。

【0028】本発明によると、光集積回路において、第 1及び第2のY分岐25、26と第2のY分岐26の分 岐枝26A、26Bに沿って設けられた位相変調器2 7、28とを有し、第1のY分岐25の一方の分岐枝2 5 A の先端に光源11を接続し他方の分岐枝25 Bの先 端に受光器13を接続し上記第2のY分岐26の各分岐 枝26A、26Bの先端に光ファイバループ19の各端 部を接続することによって光ファイバジャイロが構成さ れる光ファイバジャイロ用である。

【0029】本発明によると、光源11と光集積回路2 1と光ファイバループ19と受光器13とを有する光フ ァイバジャイロにおいて、光集積回路21は基板22と 該基板22の上面に形成された導波路23と該導波路2 30 3を横断して基板22の両側まで延在する遮断帯30 A、30Bとを有し、該遮断帯30A、30Bによって 導波路23より洩れた光が基板22内を伝播することを 防止するように構成されている。

【0030】本発明によると、光ファイバジャイロにお いて、遮断帯30A、30Bは基板22の下面に形成さ れた溝であり、導波路23を切断することなく、基板2 2の両側まで延在している。

【0031】本発明によると、光ファイバジャイロにお れた溝を含み、該溝は導波路23を切断することなく、 導波路23の両側より基板22の両側まで延在してい る.

【0032】本発明によると、光ファイバジャイロにお いて、基板22の側面と下面には反射防止膜が装着さ れ、反射防止膜によって基板22内を伝播する光が基板 22の上面以外の各面に反射することが防止される。 [0033]

【作用】本発明の光集積回路21によると、基板22内 を伝播する光は遮断帯30A、30Bによって遮られる 50 溝30A、30Bの深さは、基板22の内部を伝播する

から、基板22内をそれ以上進行することがなく、消滅 する。従って、基板22内を伝播する光が導波路23に 侵入することはない。

【0034】本発明の光集積回路21によると、基板2 2の5つの面22A、22B及び22Cに反射防止膜が 形成されているから、基板22内を伝播する光は反射防 止膜が形成された上面以外の各面22A、22B及び2 2 C より外方に放射され、従って、基板22内を伝播す ることはない。従って、基板22内を伝播する光が導波 10 路23に侵入することはない。

【0035】本発明の光ファイバジャイロによると、光 集積回路21に設けられた遮断帯30A、30Bによっ て基板22内を伝播する光が遮断されるから、導波路2 3を伝播する光にノイズが混入することがなく、従っ て、ジャイロ信号にノイズが混入することがない。

【0036】本発明の光ファイバジャイロによると、光 集積回路21の基板22の6つの面に反射防止膜が形成 されているから、基板22内を伝播する光は反射防止膜 が形成された上面以外の各面22A、22B及び22C より外方に放射され、従って、基板22内を伝播すると とはない。従って、基板22内を伝播する光が導波路2 3に侵入することはない。

[0037]

【実施例】以下に図1~図5を参照して本発明の実施例 について説明する。図1に本発明による光集積回路21 の例を示す。この光集積回路21は光ファイバジャイロ に使用されるためのもので、図示のように台形の板状に 形成されている。光集積回路21は基板22と斯かる基 板22の上面に形成された回路とを含む。斯かる回路は 導波路23と位相変調器27、28とを含み、導波路2 3は2つのY分岐25、26を含む。

【0038】光ファイバジャイロに使用する場合、第1 のY分岐25の一方の分岐25Aの先端には光源が配置 \され、第1の分岐25の他方の分岐25Bの先端には受 光器が配置される。第2のY分岐26の各分岐26A、 26Bの両側には位相変調器27、28が配置されてい る。第2のY分岐26の各分岐26A、26Bは光ファ イバループが接続される。

【0039】本発明による光集積回路21には複数の遮 いて、遮断帯30A、30Bは基板22の上面に形成さ 40 断帯30A、30Bが設けられている。斯かる遮断帯3 0 A、3 0 Bは基板22の内部を伝播する光を遮断する ように機能する。斯かる遮断帯30A、30Bは、適当 な位置に配置される。斯かる遮断帯30A、30Bは例 えば基板22の一方の側面より他方の側面まで延在する ように配置される。また、遮断帯30A、30Bを、第 1のY分岐25の一方の分岐25Aの先端に配置される べき光源11を囲むように設けてよい。

[0040]本例によると、遮断帯30A、30Bは基 板22に溝を設けることによって構成してよい。斯かる

光を遮断することができるために十分大きい寸法にす る。しかしながら、基板22が容易に破損することがな いように適当な値に設定される。

[0041] 斯かる溝30A、30Bは基板22の上面 に形成してもよく、基板22の下面に形成してもよい。 好ましくは上面と下面の両面に形成される。基板22の 内部を伝播する光は基板22の上面に形成された遮断帯 30Aによって遮断されるが、それを通過しても基板2 2の下面に形成された遮断帯30Bによって遮断され る。逆に、基板22の内部を伝播する光は基板22の下 10 面に形成された遮断帯30Bによって遮断されるが、そ れを通過しても基板22の上面に形成された遮断帯30 Aによって遮断される。とうして、両面に遮断帯、即 ち、溝30A、30Bを形成することによって基板22 の内部を伝播する光は有効に遮断される。

【0042】斯かる溝30A、30Bは基板22の上面 に形成された回路を損傷しないように、形成される。基 板22の上面の溝30A(図1Aにて実線にて示す。) は導波路23を横断しないように形成される。即ち、導 波路23の両側より基板22の両側まで延在するように 20 形成される。基板22の下面の溝30B(図1Aにて破 線にて示す。) は基板22を横断し両側面間を延在する ように形成される。

【0043】光集積回路21はフォトリソグラフィ技術 を使用して基板22の上面に導波路23と位相変調器2 7. 28を形成することによって製造される。基板22 として例えばニオブ酸リチウム(LiNbO。)又はタ ンタル酸リチウム(LiTa〇,)が使用される。導波 路23の形成方法には熱拡散法、プロトン拡散法等があ

【0044】図2に本発明による光集積回路21の他の 例を示す。この例では基板22の5つの面、即ち、前端 面及び後端面22Aと両側面22Bと下面22Cに反射 防止膜が形成されている。斯かる反射防止膜は基板22 の内部を伝播する光が基板22の各面にて反射すること なく透過するように設けられている。 基板22の内部を 伝播する光は、これらの5面22A、22B、22Cに 反射防止膜を設けないと、斯かる面にて反射し、基板2 2の内部に閉じ込められたまま基板22内を伝播する。 【0045】しかしながら、本例のように、反射防止膜 40 を形成することによって、基板22の内部を伝播する光 は、これらの5面22A、22B、22Cのいずれかを 経由して外方に放射される。従って、基板22の内部を 伝播する光が導波路23に侵入することがない。斯かる 反射防止膜は、図1に示した遮断帯30A、30Bと共 に使用してもよい。

【0046】図3及び図4は本発明の光ファイバジャイ ロの構成例を示す。本例の光ファイバジャイロは光源1 1と受光器13と光集積回路21と接続装置35とを有 する。光源 1 1 はサブキャリヤ (ヒートシンク) 1 5 に 50 材 3 1 には 1 対の終端抵抗器 4 7 、 4 7 及び電流電圧変

支持されており、斯かるサブキャリヤ15は第1の支持 部材17の上面に取り付けられている。

【0047】受光器13は第2の支持部材31の内端面 上に取り付けられ、光集積回路21は第2の支持部材3 1の上面に取り付けられている。第2の支持部材31は 第1の支持部材17に例えば1対のボルト33によって 取り付けられている。

【0048】光集積回路21には上述の遮断帯30A、 30Bが設けられている。遮断帯30A、30Bは基板 の上面に形成された溝30A及び下面に形成された溝3 0Bであってよい。斯かる基板22の5面22A、22 B、22Cに図2を参照して説明したように、反射防止 膜を形成してもよい。

【0049】本例の光ファイバジャイロには、図3に示 すように、温度調節装置が設けられており、斯かる温度 調節装置は第1の支持部材17に装着された温度センサ 41と第1の支持部材17の下面に配置された加熱冷却 装置43とを有する。加熱冷却装置43は例えばベルチ エ素子を含むものであってよい。加熱冷却装置43は基 台39の上に配置されている。

【0050】温度センサ41の感温部は好ましくは光源 11に近接して配置される。温度センサ41によって光 源温度が検出され、斯かる光源温度を指示する信号は加 熱冷却装置43に供給される。こうして、加熱冷却装置 43は光源11付近の温度が常に一定となるように調節 される。

【0051】再び図3を参照すると、光集積回路21の 傾斜した後端面には接続装置35が装着されており、斯 かる接続装置35には光ファイバループ19の両端が接 30 続されている。こうして、光ファイバループ19の両端 は接続装置35を介して導波路23の第2のY分岐26 の各分岐26A、26Bに接続されている。

【0052】光源11からの光は第1のY分岐25の一 方の分岐25Aに入射され、第1のY分岐25を経て第 2のY分岐26に導かれる。第2のY分岐26にて光は 2つに分岐され、一方の光は一方の分岐26A及び接続 装置35を経由して光ファイバループ19を右周りに伝 播し、他方の光は他方の分岐26B及び接続装置35を 経由して光ファイバループ19を左周りに伝播する。

【0053】光ファイバループ19を右周りに伝播する 光と左周りに伝播する光の両者は、第2のY分岐26の 各分岐26A、26Bに沿って配置された位相変調器2 7、28によって位相変調される。第2の位相変調器2 8はセロダイン位相変調器であってよい。

【0054】こうして、位相変調された右周りの伝播光 と左周りの伝播光は第1のY分岐26にて合成され、干 渉光は第1のY分岐25を経由して受光器13によって 受光される。受光器13は干渉光の強さ及び位相を指示 する電流信号を出力する。図示のように、第2の支持部

換器49が設けられ、終端抵抗器47、47の各々は位 相変調器27、28に接続され、電流電圧変換器49は 受光器13に接続されている。

【0055】光源11より出力された光は互いに直交す る偏光面を有し強度が等しい2つの偏光TE及びTM偏 光を含む。光ファイバジャイロでは、高い測定精度を得 るために、単一の偏光面を有する偏光が使用される。従 って、通常、光ファイバジャイロには光源11からの光 より偏光を得るための偏光分離機能が備えられている。 例えば、光路に偏光子(図7及び図8にて参照符号10 10 4にて示す。)が設けられている。

【0056】本例の光集積回路21も偏光分離機能を備 えている。プロトン交換型の光集積回路21では導波路 23が偏光子の機能を果たすので偏光子を特に設ける必 要はない。しかしながら、チタン拡散型の光集積回路2 1では導波路23が偏光子の機能を有することはないか ら、光集積回路21に偏光子29を形成する必要があ る。斯かる偏光子29は金属装荷型に形成されてよい。 【0057】図5に本発明による光ファイバジャイロの 他の例を示す。本例の光ファイバジャイロは図3及び図 20 4に示した光ファイバジャイロの例と比較して光集積回 路21のみが異なり、それ以外は同一であってよい。本 例の光集積回転21は図3に示した例の光集積回路21 と比較して、導波路23の第1のY分岐25の代わりに カプラ25Cが形成されている。基板22の上面及び下 面には遮断帯30A、30Bが設けられている。斯かる 遮断帯30A、30Bは基板22の上面及び下面に形成 した溝であってよい。この例でも基板22の上面以外の 各面に反射防止膜を設けてよい。

【0058】以上本発明の実施例について詳細に説明し 30 てきたが、本発明は上述の実施例に限ることなく本発明 の要旨を逸脱することなく他の種々の構成が採り得ると とは当業者にとって容易に理解されよう。

[0059]

【発明の効果】本発明によると、基板22内を伝播する 光は、遮断帯30A、30Bによって遮断されるから、 それが導波路23に侵入することはない利点がある。

【0060】本発明の光ファイバジャイロによると、光 集積回路21に設けられた遮断帯30A、30Bによっ て基板22内を伝播する光が遮断されるから、導波路2 40 3を伝播する光にノイズが混入することがなく、従っ て、ジャイロ信号にノイズが混入することがない利点が ある。

【0061】本発明によると、基板22の上面以外の各 面22A、22B、22Cに反射防止膜が形成されてお り、基板22内を伝播する光は基板22内に閉じ込めら れることなく外方に放射されるから、基板22内を伝播 する光が導波路23に侵入することがない利点がある。 【0062】本発明の光ファイバジャイロによると、光

集積回路21の基板22の上面以外の各面22A、22 50 107 電流電圧変換器

B、22Cに反射防止膜が形成されており、基板22内 を伝播する光は基板22内に閉じ込められることなく外 方に放射されるから、基板22内を伝播する光が導波路 23に侵入することがなく、導波路23を伝播する光に ノイズが混入することがなく、従って、ジャイロ信号に ノイズが混入することがない利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ファイバジャイロの第1の例の平面 構成を示す図である。

【図2】本発明の光ファイバジャイロの第1の例の正面 構成を示す図である。

【図3】本発明の光ファイバジャイロの一部の詳細を示 す図である。

【図4】本発明の光ファイバジャイロの一部の詳細を示 す図である。

【図5】本発明の光ファイバジャイロの第2の例の平面 構成を示す図である。

【図6】従来の光ファイバジャイロの例を示す図であ ろ.

【図7】従来の光源モジュールを示す図である。

【図8】従来の光ファイバジャイロの例を示す図であ る.

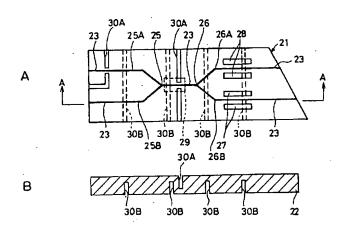
【符号の説明】

- 11 光源
- 13 受光器
- 15 サブキャリア
- 17 支持部材
- 19 光ファイバループ
- 21 光集積回路
- 22 基板
 - 23 導波路
 - 25、26 Y分岐
 - 250 カプラ
 - 27、28 位相変調器
 - 29 偏光子
 - 30A、30B 遮断带、溝
 - 31 支持部材
 - 33 ボルト
 - 35 接続装置
- 39 基台
 - 41 温度センサ
 - 43 加熱冷却装置
 - 47 終端抵抗器
 - 49 電流電圧変換器
 - 101 光源
 - 102 受光器
 - 103 光ファイバループ
 - 104 偏光子
 - 105、106 カプラ

. 12

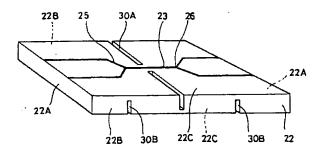
	11	• , 12
108,	108' 位相変調器	* 1 2 3 光源支持台
109	信号発生器	125 基台
110	同期検波器	127 光検出器
115	光集積回路	131 光ファイバ
116	接続装置	133 支持台
117	接続部	133A 上面
118	Y分岐	135 V溝
121	光源	*

[図1]



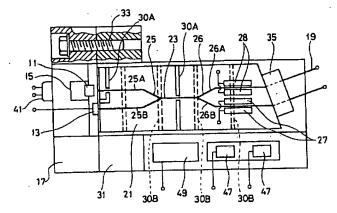
本発明による光角積回路の例

【図2】



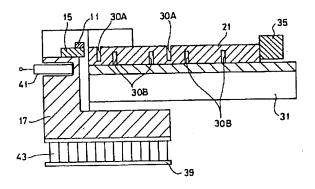
本発明による光幕標回路の例

【図3】



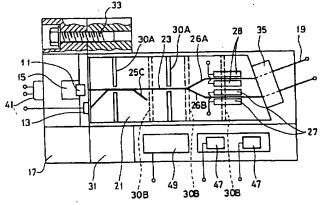
木苑明による光ファイバジャイロの平面構成

【図4】



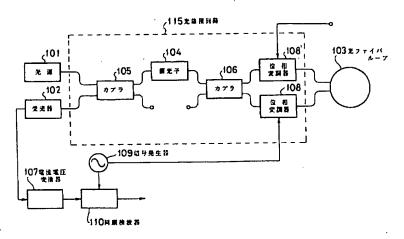
表が明による光ファイバジャイロの正面構成

[図5]



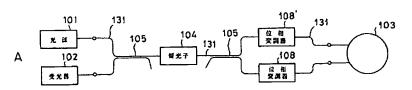
本発明による光ファイバジャイロの他の例

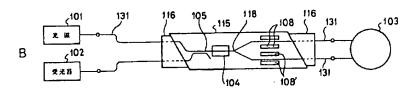
【図6】



従来の光ファイバジャイロの例

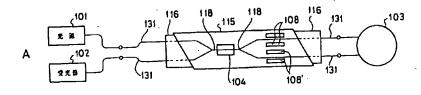
【図7】

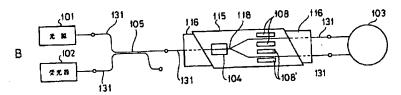




従来の光ファイバジャイロの例

【図8】





光集積回路を使用した光ファイバジャイロの例

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 S 3/083